

Comunicado de prensa

KIOXIA empieza a enviar muestras de dispositivos BiCS FLASH™ de 1 TB TLC de novena generación

Los nuevos dispositivos combinan la célula de memoria actual con tecnologías CMOS avanzadas para lograr una alta eficiencia de inversión

Düsseldorf (Alemania), 6 de agosto de 2026: [KIOXIA Europe GmbH](#), líder mundial en soluciones de memoria, ha anunciado que KIOXIA Corporation ha empezado a enviar muestras de dispositivos de memoria de 1 TB (terabit) de tipo Triple-Level Cell (TLC) que incorporan su tecnología de memoria flash 3D BiCS FLASH™ de novena generación^[1]. Estos dispositivos están diseñados para aplicaciones como ordenadores y smartphones con IA que tienen capacidades de almacenamiento de nivel bajo a medio y que requieren un alto rendimiento.

KIOXIA sigue apostando por una estrategia de doble eje basada en su innovadora tecnología CMOS directamente unida a la matriz (CBA)^[2] y en la tecnología On-Pitch Select Gate Drain (OPS)^[3]. En el marco de esta estrategia única de doble eje, KIOXIA está desarrollando en paralelo dos líneas de productos distintas: sus soluciones de 9.ª generación, que ofrecen un alto rendimiento con un coste de inversión relativamente bajo, y su tecnología de 10.ª generación, que aprovecha el apilamiento avanzado de capas para lograr una capacidad enorme y un rendimiento superior.

Los nuevos dispositivos BiCS FLASH™ TLC de 1 TB de 9.ª generación, desarrollados mediante un proceso de apilamiento de 230 capas basado en la tecnología BiCS FLASH™ de 8.ª generación y



en tecnología CMOS avanzada, ofrecen una velocidad de interfaz NAND de 4,8 GB/s, lo que supone una mejora del 33 % respecto a los dispositivos de 8.^a generación y equipara el rendimiento de los dispositivos de 10.^a generación^[4].

Guiada por su misión de «mejorar el mundo con la “memoria”», KIOXIA sigue comprometida con impulsar la innovación tecnológica, fortalecer las colaboraciones internacionales y ofrecer soluciones de almacenamiento avanzadas que impulsen la infraestructura moderna de IA.

#

Notas:

1: Estas muestras se han fabricado con el fin de comprobar su funcionalidad; las especificaciones reales pueden variar en la producción en serie.

2: Tecnología mediante la cual cada oblea CMOS y cada oblea de matriz de celdas se fabrican por separado en condiciones optimizadas individualmente y, a continuación, se unen entre sí. Esta tecnología se ha adoptado desde los productos BiCS FLASH™ de 8.^a generación.

3: Tecnología que permite acortar la línea de bits y reducir la capacitancia de la línea de palabras eliminando los agujeros de memoria que no se usan. Esta tecnología se ha adoptado desde los productos BiCS FLASH™ de 8.^a generación.

4: 1 GB/s equivale a 1 000 000 000 de bits por segundo. Este valor se obtuvo en un entorno de pruebas específico de KIOXIA Corporation. Los resultados pueden variar en el uso real dependiendo de las condiciones de uso.

La densidad del producto se identifica en función de la densidad de los chips de memoria de dentro del producto, no de la cantidad de capacidad de memoria disponible para el almacenamiento de datos por parte del usuario final. La capacidad útil para el usuario será menor debido a las áreas de datos de gestión, el formateo, los bloques defectuosos y otras limitaciones, y también puede variar en función del dispositivo host y la aplicación. Para obtener más información, consulte las especificaciones del producto. 1 GB = 2^{30} bits = 1 073 741 824 bits.

Las velocidades de lectura y escritura son los mejores valores obtenidos en un entorno de pruebas específico de KIOXIA Corporation. La empresa no garantiza las velocidades de lectura ni de escritura en dispositivos individuales. Las velocidades de lectura y escritura pueden variar según el dispositivo que se utilice.

Los nombres de empresas, nombres de productos y nombres de servicios mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de empresas terceras.

**Acerca de KIOXIA Europe GmbH**

KIOXIA Europe GmbH es la filial europea de KIOXIA Corporation, un proveedor líder mundial de memorias flash y unidades de memoria de estado sólido (SSD). Desde la invención de la memoria flash NAND hasta la popular memoria flash 3D BiCS FLASH™, KIOXIA sigue siendo pionera en soluciones y servicios de memoria de vanguardia que enriquecen la vida de las personas y amplían los horizontes de la sociedad. La innovadora tecnología de memoria flash 3D BiCS FLASH™ de la empresa está moldeando el futuro del almacenamiento en aplicaciones de alta densidad, incluidos los smartphones avanzados, ordenadores de sobremesa, los sistemas automotrices, los centros de datos y los sistemas de IA generativa.

Visite nuestro [sitio web de KIOXIA](#)

Datos de contacto para la publicación:

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 183, 40549 Düsseldorf (Alemania)

Tel.: +49 (0)211 368 77-0

Correo electrónico: KIE-support@eu.kioxia.com

Datos de contacto para consultas editoriales:

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tel.: +49 (0) 211 36877 382

Correo electrónico: lena.hoffmann@eu.kioxia.com

Publicado por:

Birgit Schöniger, Pretzl GmbH

Tel.: +49 (0)172 617 8431

Correo electrónico: birgit.schoeniger@pretzl.com

Web: www.pretzl.com